4, с. 68

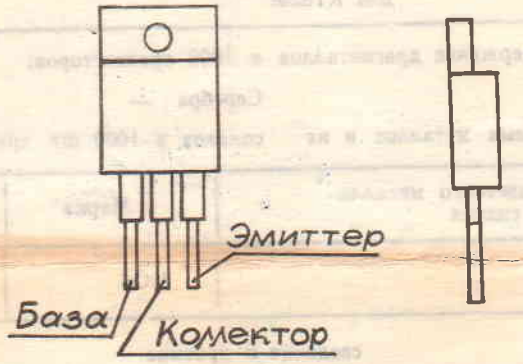
Транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В КТ829Г

ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза-планарные составные п-р-п мощные транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В, КТ829Г, в пластмассовом корпусе предназначены для работы в усилителях низкой частоты, ключевых схемах.

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1,5.1

Корпус типа КТ-28-2 по ГОСТ 18472-82



Масса транзистора не более 3 г.

Таблица 1

Основные электрические параметры при Т корп. —25 10 гр. С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения		Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Статистический коэффициент передачи тока (Икэ—3 В, Iк—3 А)		п21э	750	
Обратный ток коллектора, мА		Iкбо		
Икб—100В	для КТ829А		—	0,2
Икб—80 В	для КТ829Б		—	0,2
Икб—60 В	для КТ829В		—	0,2
Икб—40 В	для КТ829Г		—	0,2
Обратный ток эмиттера (Иэб—5 В, Iк—0), мА		Iэбо		2,0
Граничное напряжение, В		Икэо гр.		
для КТ829А	—40 мГн		100	—
для КТ829Б			80	—
для КТ829В	Iк нас —0,3 А		60	—
для КТ829Г			45	—
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Iк—3 А, Iб—0,012 А), В		Икэ нас		2

conector.by

Продолжение табл. 1

Напряжение насыщения база-эмиттер (Iк—3 А, Iб—0,012 А). В	Ибэ нас	—	2,5
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте (Икэ —3 В, Iк—3 А, — 10 МГц	(21э)	0,4	—
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА	Iкэо		
Икэ—50 В	для КТ829А	—	0,5
Икэ—40 В	для КТ829Б	—	0,5
Икэ—30 В	для КТ829В	—	0,5
Икэ—20 В	для КТ829Г	—	0,5

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота—0,3347 г Серебра —

Содержание цветных металлов и их сплавов в 1000 шт. транзисторов

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса г.
Медь	М06	1820 г

сведения о приемке

Транзисторы КТ829А, КТ829Б, КТ829В. КТ829Г соответствуют техническим условиям аАО. 336. 292ТУ

Штамп ОТК 706

Штамп Государственной приемки

Указания по эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации транзисторов по ГОСТ 11630-84, ОСТ II 336. 907: 0-79:

Транзисторы необходимо применять с тепловодами. Крепление транзисторов к теплоотводам должно обеспечивать надежный тепловой контакт. Для улучшения теплового контакта необходимо наносить на нижнее основание корпуса транзистора жидкость ПМС-100 по ГОСТ 13032-77 или другую теплопроводящую смазку.

При пайке выводов температура корпуса транзистора не должна превышать 85 гр. С.

Допускается формировка выводов транзисторов в направлении, перпендикулярном плоскости его основания. Минимально допустимое расстояние от корпуса до места изгиба 3 мм.

Формировку проводить с обязательной фиксацией выводов. Место фиксации — между корпусом и местом изгиба.

Шелковская тип. 1990 г. 1000 экз. Зак. N

conector.by